

[1 7 0 1 7]

極微小デバイスへの放射線照射損傷機構の解明

学術論文（査読あり）

[1] J.M.Rafi, Takakura, Tsunoda, Yoneoka, et. al, “Four-quadrant Silicon and Silicon Carbide Photodiodes for Beam Position Application: Electrical Characterization and Electron Irradiation Effects,” Journal of Instrumentation, Volume 13, C01045 (2018).

卒業論文

[1] 登田, 「極低温環境下におけるダイヤモンドショットキーPN ダイオードの電气的特性評価」, 熊本高等専門学校専攻科特別研究論文, (2018).

[2] 井芹, 「3次元ゲート FET の放射線耐性評価及び欠陥解析」, 熊本高等専門学校専攻科特別研究論文, (2018).

国際会議

[1] J.M.Rafi, 高倉, 角田, 米岡ほか, ”Four-quadrant Silicon and Silicon Carbide Photodiodes for Beam Position Application: Electrical Characterization and Electron Irradiation Effects,” The 11th International Conference on Position Sensitive Detectors, The Open University, Milton Keynes, UK, 3-8 Sept. (2017).

[2] 松木, 角田, 高倉ほか, ”Study of degradation mechanism by isothermal annealing of SOI FinFET after electron irradiation,” 29th International Conference on Defects in Semiconductors, TuP-3 (2017).

[3] 井芹, 角田, 高倉ほか, ”Radiation influence on the electrical properties of n-channel SOI GAAFETs by 2 MeV electron irradiation,” 29th International Conference on Defects in Semiconductors, ThP-5 (2017).

国内会議

[1] 登田, 高倉, 米岡, 角田ほか, ”n-MOSFET の放射線照射による劣化特性評価,” 日本原子力学会九州支部第 36 回研究発表講演会, 福岡, 2017 年 12 月 2 日.

[2] 井芹, 米岡, 角田, 高倉ほか, “Evaluation of degradation characteristics of n-MOSFET by radiation irradiation,” 日本原子力学会九州支部第 36 回研究発表講演会, 福岡, 2017 年 12 月 2 日.

[3] 松木, 米岡, 角田, 高倉ほか, “Study on electrical characteristics of electron irradiated SOI FinFETs by isothermal annealing,” 日本原子力学会九州支部第 36 回研究発表講演会, 福岡, 2017 年 12 月 2 日.